## Электродинамический анализ зеркальных антенн самосогласованным методом

## © Д.С. Клюев, Ю.В. Соколова

11

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 443010 Самара, Россия e-mail: klyuevd@yandex.ru

## (Поступило в Редакцию 29 января 2014 г.)

Работа посвящена электродинамическому анализу зеркальных антенн (ЗА) самосогласованным методом. Математическая модель таких антенн сведена к системе двумерных гиперсингулярных интегральных уравнений (ГСИУ). В качестве примера проведен анализ ЗА с рефлектором в виде параболического цилиндра. Представлены диаграммы направленности такой антенны, а также распределения плотности токов на поверхностях рефлектора и облучателя.

Анализ любой ЗА сводится к решению задачи дифракции электромагнитной волны, возбуждаемой облучателем, на рефлекторе (зеркале). Как известно, существует ряд методов решения подобных задач, среди которых можно выделить следующие: метод геометрической оптики, метод физической оптики и асимптотические методы (геометрическая теория дифракции (ГТД) и физическая теория дифракции (ФТД)). Эти методы имеют ряд существенных ограничений, одно из которых это невозможность корректного расчета поля в ближней зоне излучения, что очень важно при решении задач электромагнитной совместимости.

В последние десятилетия разработаны строгие методы, основанные на решении уравнений Максвелла методом конечных разностей во временной области, например, метод FDTD. Он применен, в частности, в распространенных в настоящее время коммерческих программах CST MicrowaveStudio и Ansoft HFSS. Однако для расчета сложных антенных систем с помощью этих программ требуются громадные вычислительные ресурсы.

Этих недостатков лишен метод интегральных уравнений. Общий подход к решению задач дифракции таким методом развит в работах А.С. Ильинского. В [1] последовательно исследуются математические модели теории дифракции, дано математическое обоснование корректности математических задач, исследованы вопросы существования и единственности решений задач теории дифракции. Метод сингулярных интегральных уравнений для электродинамического анализа одномерных излучающих структур развит в работах В.А. Неганова [2]. Решение задач дифракции на незамкнутых поверхностях методом ГСИУ [3] описано в [4]. В настоящей работе описан метод электродинамического анализа ЗА, основанный на математическом аппарате ГСИУ.

При расчете будем использовать следующую физическую модель ЗА. ЗА в общем случае может иметь несколько рефлекторов и облучателей, а антенная система может состоять из нескольких ЗА, и так как их электродинамический анализ выполняется по одному принципу, то при общей постановке задачи не будем делать разницы между рефлекторами и облучателями, а назовем их излучающими структурами. Итак, ЗА представляет собой N излучающих структур (рис. 1). Каждая n-я излучающая структура представляет собой бесконечно тонкую идеально проводящую поверхность S<sub>n</sub>, возбуждаемую электромагнитным полем, которое в общем случае является суперпозицией полей волн, отраженных от других структур и стороннего поля, возбужденного генератором, подключенного к данной структуре, если данная структура является облучателем. Как конкретно происходит запитывание облучателей, в настоящей работе не рассматривается, предполагается лишь, что питающий фидер идеально согласован с облучателем. Справедливо следующее выражение для определения напряженности электрического поля Е, возбуждаемого токами всех N излучателей, входящих в состав антенны,



Рис. 1. Геометрия зеркальной антенны с произвольной формой рефлекторов и облучателей.

в данной точке пространства:

$$i\omega\varepsilon_{a} \mathbf{E} = \sum_{n=1}^{N} \int_{S} \left[ k^{2} \boldsymbol{\eta}_{n}(q) G(p,q) + \operatorname{grad}_{p} \operatorname{div}_{p} \left( \boldsymbol{\eta}_{n}(q) G(p,q) \right) \right] dS, \qquad (1)$$

где  $\omega$  — циклическая частота,  $\varepsilon_a$  — абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, k — волновое число, G(p,q) — функция Грина, p,q — координаты точки наблюдения и точки источника соответственно,  $S_n$  — излучающая поверхность,  $\eta_n(q)$  — плотность полного тока, наведенного на поверхности  $S_n$  (т. е. сумма плотностей токов, наведенных на обеих ее сторонах) [4]. Индекс p в операторах div и grad означает, что дифференцирование производится по координатам точек наблюдения. Используя известное соотношение [5]

$$div_p(\boldsymbol{\eta}_n(q)G(p,q)) = (grad_p G(p,q), \boldsymbol{\eta}_n(q)) + G(p,q)div_p \boldsymbol{\eta}_n(q)$$

и учитывая, что в рассматриваемом случае div<sub>p</sub>  $\eta_n(q) = 0$ , выражение (1) можно преобразовать к виду

$$i\omega\varepsilon_{a}\mathbf{E} = \sum_{n=1}^{N} \int_{S} \left[ k^{2}\boldsymbol{\eta}_{n}(q)G(p,q) + \operatorname{grad}_{p}\left(\operatorname{grad}_{p}G(p,q),\boldsymbol{\eta}_{n}(q)\right) \right] dS.$$
(2)

Каждый п-й излучатель привяжем к системе координат. В общем случае это криволинейная система координат, причем для удобства дальнейших расчетов для каждой п-й структуры выберем свою систему координат  $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$  в соответствии с их геометрической формой. Излучающая поверхность *n*-го излучателя S<sub>n</sub> совпадает с частью координатной поверхности  $\alpha_n = \alpha 0_n$ , ограниченной по координате  $\beta_n$  отрезком [ $\beta_{n1}, \beta_{n2}$ ], а по координате  $\gamma_n$  отрезком [ $\gamma_{n1}, \gamma_{n2}$ ]. Плотность тока на поверхности излучателя  $\boldsymbol{\eta}_n(q)$  будет иметь лишь две составляющие (касательные к поверхности S<sub>n</sub>) —  $\eta_{n\beta'}$  и  $\eta_{n\gamma'}$ . Переходя от векторных выражений (2) к скалярным и подставляя их в граничные условия  $E_{m \tau_m} = -E_{m \tau_m}^{\text{ext}} \ (\tau_m = \beta_m, \gamma_m),$ где  $E_{m \tau_m}^{\text{ext}}$  — тангенциальная составляющая напряженности стороннего электрического поля на поверхности *m*-го излучателя, равная напряженности поля волны, подведенной от генератора, если структура является облучателем, и равная нулю, если структура является рефлектором, можно записать следующую систему интегральных уравнений относительно неизвестных составляющих плотности тока на излучателях —  $\eta_{n\beta'}$  и  $\eta_{n\gamma'}$ :

$$-i\omega\varepsilon_{a}E_{m\,\tau_{m}}^{\text{ext}} = \sum_{n=1}^{N}\int_{\beta_{n1}}^{\beta_{n2}}\int_{\gamma_{n1}}^{\gamma_{n2}} \left[k^{2}(\eta_{n\beta'}\xi_{\beta'_{n}\tau_{m}} + \eta_{n\gamma'}\xi_{\gamma'_{n}\tau_{m}})G_{nm} + \frac{1}{h_{\tau_{m}}}\frac{\partial}{\partial\tau_{m}}\left(\frac{1}{h_{\alpha_{m}}}\frac{\partial G_{nm}}{\partial\alpha_{m}}(\eta_{n\beta'}\xi_{\beta'_{n}\alpha_{m}} + \eta_{n\gamma'}\xi_{\gamma'_{n}\alpha_{m}}) + \frac{1}{h_{\beta_{m}}}\frac{\partial G_{nm}}{\partial\beta_{m}}(\eta_{n\beta'}\xi_{\beta'_{n}\beta_{m}} + \eta_{n\gamma'}\xi_{\gamma'_{n}\beta_{m}}) + \frac{1}{h_{\gamma_{m}}}\frac{\partial G_{nm}}{\partial\gamma_{m}}(\eta_{n\beta'}\xi_{\beta'_{n}\gamma_{m}} + \eta_{n\gamma'}\xi_{\gamma'_{n}\gamma_{m}})\right) h_{\beta'_{n}}h_{\gamma'_{n}}d\beta'_{n}d\gamma'_{n},$$
(3)

где

$$G_{nm} = G(\alpha 0_m, \beta_m, \gamma_m, \alpha 0_n, \beta'_n, \gamma'_n)$$

$$= \frac{\exp[-ikR(\alpha 0_m, \beta_m, \gamma_m, \alpha 0_n, \beta'_n, \gamma'_n)]}{4\pi R(\alpha 0_m, \beta_m, \gamma_m, \alpha 0_n, \beta'_n, \gamma'_n)},$$

$$R_{nm}(\alpha 0_m, \beta_m, \gamma_m, \alpha 0_n, \beta'_n, \gamma'_n) = \left[ \left( x(\alpha 0_m, \beta_m, \gamma_m) - x(\alpha 0_n, \beta'_n, \gamma'_n) \right)^2 + \left( y(\alpha 0_m, \beta_m, \gamma_m) - y(\alpha 0_n, \beta'_n, \gamma'_n) \right)^2 + \left( z(\alpha 0_m, \beta_m, \gamma_m) - z(\alpha 0_n, \beta'_n, \gamma'_n) \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}},$$

 $h_{\alpha,\beta,\gamma}$  — коэффициенты Ламе,  $R_{nm}$  — расстояние от точки источника  $q(\alpha 0_n, \beta'_n, \gamma'_n)$ , находящейся на поверхности *n*-го излучателя  $(n = \overline{1, N})$ , до точки наблюдения  $p(\alpha 0_m, \beta_m, \gamma_m)$ , находящейся на поверхности *m*-го излучателя  $(m = \overline{1, N})$ ,  $\xi_{qp}$  — элементы матрицы ортогонального поворота, которые по сути являются проекциями единичных ортов  $\mathbf{i}_{\alpha'}, \mathbf{i}_{\beta'}, \mathbf{i}_{\gamma'}$  на единичные орты  $\mathbf{i}_{\alpha}, \mathbf{i}_{\beta}, \mathbf{i}_{\gamma}$ при переносе первых параллельно самим себе из точки источника  $q(\alpha', \beta', \gamma')$  в точку наблюдения  $p(\alpha, \beta, \gamma)$ .

Некоторые ядра интегральных уравнений (3) являются сингулярными и гиперсингулярными, так как при  $R_{nm} = 0$  они обращаются в бесконечность. Такая ситуация возможна только для слагаемого с n = m, которое



Рис. 2. Зеркальная антенна с рефлектором в виде параболического цилиндра.



**Рис. 3.** Распределение плотности тока на рефлекторе: a — сечение z = 0, b — сечение  $\beta = 0$ .



**Рис. 4.** Диаграммы направленности зеркальной антенны с рефлектором в виде параболического цилиндра:  $a - F(\theta, 90^{\circ})$  (в горизонтальной плоскости  $\varphi = 90^{\circ}$ ),  $b - F(60^{\circ}, \varphi)$  (в вертикальной плоскости  $\theta = 60^{\circ}$ ).

соответствует полю, наводимому токами излучателя на его же собственной поверхности. Для того чтобы упростить в дальнейшем численный алгоритм решения этой системы, необходимо выделить особенности в сингулярных и гиперсингулярных ядрах следующим образом. Необходимо к функции Грина  $G_{mm}$  прибавить и вычесть слагаемое

$$G_{m0} = \frac{1}{4\pi} \left( \frac{1}{R_{mm}} - ik - \frac{k^2 R_{mm}}{2} \right)$$

Функция  $G_{m0}$  является произведением разложения функции  $\exp(-ikR_{mm})$  в ряд Тейлора в окрестности точки  $R_{mm} = 0$  на  $R_{mm}^{-1}$ . После выделения особенностей решить систему ГСИУ (3) можно, например, методом дискретных вихрей [3].

В качестве примера рассмотрим ЗА с рефлектором в виде параболического цилиндра. Рефлектор представляет собой бесконечно тонкий идеально проводящий параболический цилиндр с фокусом f (рис. 2). Его раскрыв (апертура) имеет конечные размеры  $2a \times 2b$ . Рефлектор возбуждается облучателем. В качестве облучателя использован полосковый вибратор, который представляет собой бесконечно тонкую идеально проводящую полоску длиной 2l и шириной 2w, возбуждаемую в зазоре шириной 2Д генератором высокой частоты. Ширина вибратора много меньше его длины и длины волны, поэтому при дальнейшем анализе учитывается лишь продольная составляющая плотности тока на его поверхности  $\eta_{\tau'}^{\text{refl}}$ , т.е. будем считать  $\eta_{x'}^{\text{refl}} = 0$ . Для анализа облучателя (вибратора) будем использовать декартову систему координат, а для анализа рефлектора удобно использовать систему координат параболического цилиндра  $\alpha$ ,  $\beta$ , z [5]. Система ГСИУ (3) позволяет использовать для анализа рефлектора и облучателя различные системы координат.

Были рассчитаны характеристики ЗА с рефлектором в виде параболического цилиндра с апертурой  $10\lambda \times 10\lambda$  и фокусом  $f = 3\lambda$ . В качестве облучателя использован полуволновый вибратор ( $2l = 0.5\lambda$ ) шириной  $2w = 0.05\lambda$ , расположенный в фокусе рефлектора.

На рис. 3 представлены распределения модуля плотности тока на поверхности рефлектора

$$\left|\sqrt{\eta_{\beta}^2(\beta,z)+\eta_z^2(\beta,z)}\right|$$

(a — сечение z = 0, b — сечение  $\beta = 0$ ).

На рис. 4 представлены диаграммы направленности. Как видно из рисунка, основная часть энергии падающей волны отражается от зеркала, однако так как зеркало имеет конечные размеры, часть ее проходит за него. В вертикальной плоскости происходит фокусировка. Результаты расчетов совпали с результатами численного моделирования в системе CST Microwave Studio. Предложенной методикой несложно рассчитывать характеристики ЗА с рефлекторами более сложной формы (параболоид, гиперболоид и т.д.), а также с другими облучателями.

## Список литературы

- [1] Ильинский А.С., Кравцов В.В., Свешников А.Г. Математические модели электродинамики. М.: Высшая школа, 1991. 224 с.
- [2] Неганов В.А. Физическая регуляризация некорректных задач электродинамики. М.: Сайнс-Пресс, 2008. 450 с.
- [3] Вайникко Г.М., Лифанов И.К., Полтавский Л.Н. Численные методы в гиперсингулярных интегральных уравнениях и их приложения. М.: Янус-К, 2001. 508 с.
- [4] Давыдов А.Г., Захаров Е.В., Пименов Ю.В. Метод численного решения задач // ДАН СССР. 1984. Т. 276. № 1. С. 96-100.
- [5] Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров. Пер. с франц. / Под ред. К.С. Шифрина. М.: Наука, 1965. 780 с.